

		Перв. примен.		Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание					
Справ. №												
					<u>Диоды Шоттки</u>							
				VD1	VS-10MQ100-M3/5AT (V1J), 1A, 100B[SMA/DO-214AC]	1						
					<u>Кварцевые резонаторы</u>							
				ZQ1	HS-49SM 8.000 МГц	1						
					<u>Кнопки</u>							
				SB1	KLS-TS6604-7.0-180-B(T)	1						
					<u>Конденсаторы</u>							
				C1	TECAP SMD эл-лит. (Китай), 100 мкФ, 16В, тип D, 10%	1						
				C3	ECAP SMD (K50-35) (Тайвань), 330 мкФ, 10В, 20%	1						
				C2, C9-C12, C4	Керам SMD (Murata, Япония), 100 нФ, 250В, X7R, 20%,	4						
				C5, C7	Керам SMD (Тайвань), 20 нФ, 50В, NP0, 5%	2						
				C6	Керам. SMD (Тайвань), 1мкФ, 50В, X7R, 10%	1						
					<u>Микросхемы</u>							
Инв. № дцбл.				DA1	AMS 1117-3.3, 800мА, 3.3В, [SOT223]	1						
				DD1	STM32F103C8T6, Cortex-M3, 32 бита, 72МГц, LQFP48	1						
					<u>Резисторы</u>							
				R3, R4	0.125В, 0805, 20 Ом, 1%	2						
				R6, R7	0.125В, 0805, 510 Ом, 1%	2						
				R1, R5, R8, R9	0.125В, 0805, 10 кОм, 1%	4						
				R2	0.125В, 0805, 1 МОм, 1%	1						
					<u>Разъём</u>							
Подп. и дата				XP1	PLS-4R	1						
				XP2	PLS-8R	1						
							ИЧ4.11.03.03.20.63.13.004 ПЭЗ					
Инв. № подл.				Разраб.	Меликян С. А.		Устройство считывания RFID карт			Лит	Лист	Листов
				Провер.	Гладких А.А.						1	2
										МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра ИЧ-4 Группа ИЧ4-63Б		
				Н. контр.								
				Утверд.								

Зона	Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание					
Перв. примен.	XS1	KLS1-233-0-0-1-T,(Micro-USB 5S-B)	1						
		<u>Светодиоды</u>							
	VD2,VD3	EK-HL 1206RGBWY 0805	2						
Справ. №									
Подп. и дата									
Инв.№ дцдл.									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ИЧ4.11.03.03.20.63.13.004 ПЭЗ				Лист
									2